

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/038891 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/28, 21/288, B05D 3/00,  
B32B 15/01, C01B 33/04, C07F 17/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015101

(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 6 日 (06.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2003-356158  
2003 年 10 月 16 日 (16.10.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR  
株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒104-0045  
東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松本 安生 (MAT-  
SUKI, Yasuo) [JP/JP]; 〒104-0045 東京都中央区築地  
五丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP). 王  
道海 (WANG, Daohai) [CN/JP]; 〒104-0045 東京都中  
央区築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo  
(JP). 酒井 達也 (SAKAI, Tatsuya) [JP/JP]; 〒104-0045 東  
京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会  
社内 Tokyo (JP). 岩沢 晴生 (IWASAWA, Haruo) [JP/JP]; 〒  
104-0045 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR  
株式会社内 Tokyo (JP).

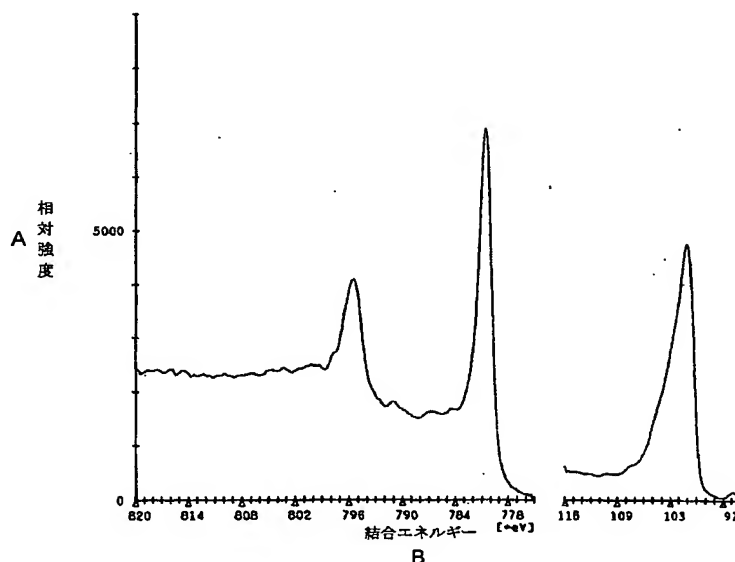
(74) 代理人: 大島 正孝 (OHSHIMA, Masataka); 〒160-0004  
東京都新宿区四谷四丁目 3 番地 福屋ビル 大島特許  
事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[続葉有]

(54) Title: COMPOSITION FOR FORMING SILICON-COBALT FILM, SILICON-COBALT FILM AND METHOD FOR FORMING SAME

(54) 発明の名称: シリコン・コバルト膜形成用組成物、シリコン・コバルト膜およびその形成方法



A... RELATIVE INTENSITY  
B... BINDING ENERGY

(57) Abstract: Disclosed are a composition and a method for forming a silicon-cobalt film at low production cost without requiring an expensive vacuum apparatus or high-frequency wave generating apparatus. A composition for forming a silicon-cobalt film contains a silicon compound and a cobalt compound. A silicon-cobalt film is formed by applying this composition to a base and treating it with heat or light.

[続葉有]



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 高価な真空装置や高周波発生装置を必要とせず、製造コストが安く、シリコン・コバルト膜を形成するための組成物と方法を提供する。シリコン化合物およびコバルト化合物を含有するシリコン・コバルト膜形成用組成物。この組成物を基体に塗布し、熱や光により処理するとシリコン・コバルト膜が形成される。